

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА Ф. А. КУЗНЕЦОВА (1932–2014)



14 февраля 2014 г. ушел из жизни действительный член Российской академии наук, советник РАН Федор Андреевич Кузнецов — основатель и признанный лидер научной Школы по химии функциональных материалов, ведущий специалист в нашей стране и за рубежом в области разработки научных основ создания материалов для микроэлектронной техники.

Научная деятельность Ф. А. Кузнецова началась во время учебы в Ленинградском государственном университете. Первые его работы были связаны с радиохимией, затем — с химической термодинамикой. Этот интерес и привел Федора Андреевича в Сибирское отделение АН СССР, где он стал аспирантом (1958 г.), защитил кандидатскую диссертацию (1961 г.), возглавил лабораторию пленочных полупроводников и покрытий (1962 г.), а в 1972 г. защитил докторскую диссертацию по применению летучих соединений различных элементов Периодической системы для создания материалов электронной техники. В 1976 г. Ф. А. Кузнецов получил звание профессора, в 1984 г. был избран членом-корреспондентом, а в 1987 г. — действительным членом АН СССР. С 1983 по 2005 гг. академик Ф. А. Кузнецов занимал пост директора Института неорганической химии СО РАН, после чего выполнял обязанности советника РАН.

Научно-исследовательскую работу Федор Андреевич сочетал с активной педагогической деятельностью в Новосибирском государственном университете, где он многие годы читал курс лекций «Функциональные материалы». Он — признанный глава научной школы, заведовал кафедрой в Новосибирском государственном университете, многократно приглашался для чтения лекций в ведущие научные центры. Ф. А. Кузнецов являлся Почетным профессором Шеньянского университета химической технологии (Китай).

Основные направления научных исследований Ф. А. Кузнецова — разработка физико-химических

основ создания материалов и структур с заданными свойствами для микро-, нано- и оптоэлектроники, экспериментальное и теоретико-расчетное изучение процессов синтеза и деградации материалов и структур. В результате этих работ была разработана методология количественного исследования одного из наиболее используемых в микроэлектронной технологии типа процессов — химического осаждения из газовой фазы, обоснована содержательность и развита техника термодинамического моделирования процессов синтеза материалов и структур.

Ф. А. Кузнецов инициировал работы по развитию информационного обеспечения исследований в материаловедении и структурной химии. Под его руководством в Институте создан Банк данных свойств материалов электронной техники (СМЭТ), включающий базу кристаллоструктурных данных и комплекс оригинальных программ для верификации самих данных.

Ф. А. Кузнецов много сделал по организации совместных научных исследований, укреплению и развитию международных связей, особенно с китайскими, индийскими, японскими и южнокорейскими учеными. Он возглавлял материаловедческое направление в долгосрочной программе научно-технического сотрудничества России и Индии (ILTR), являлся президентом Азиатско-Тихоокеанской академии материалов (АРАМ), вице-президентом в CODATA, почетным профессором Шеньянского университета химической технологии (КНР), членом редколлегий ряда зарубежных журналов.

Научные достижения академика Ф. А. Кузнецова отмечены Государственной премией РФ за цикл исследований по химической термодинамике полупроводников (1981 г.) и многими наградами.

Светлая память о Федоре Андреевиче сохранится в наших сердцах.

Коллеги, друзья и редакционная коллегия журнала «Известия вузов. Материалы электронной техники».